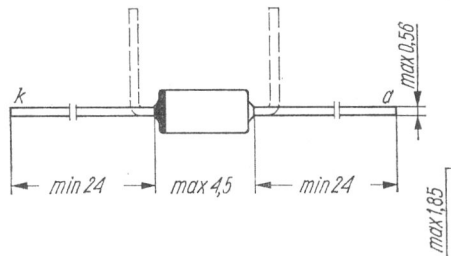


BAW62



Typ diody: dioda krzemowa

Firma: PHILIPS

Wykonanie: dioda krzemowa epitaksjalno-planarna w obudowie DO-35

Zastosowanie: szybkie układy przełączające, układy logiczne

Typy podobne: BAW76 (Sie)

Rys. 2-66. BAW62

Wartości charakterystyczne¹⁾

U_F	0,62 ÷ 0,75	V	przy $I_F = 5$ mA
U_F	< 1	V	przy $I_F = 100$ mA
U_F	< 0,93	V	przy $I_F = 100$ mA, $t_j = 100^\circ\text{C}$
I_R	< 25	nA	przy $U_R = 20$ V
I_R	< 50	μA	przy $U_R = 20$ V, $t_j = 150^\circ\text{C}$
I_R	< 5	μA	przy $U_R = 75$ V
I_R	< 100	μA	przy $U_R = 75$ V, $t_j = 150^\circ\text{C}$
C_d	< 4	pF	przy $U_R = 0$, $f = 1$ MHz
U_{FM}	< 2,5	V	przy $I_F = 50$ mA, $t_r = 20$ ns
t_{rr}	< 4	ns	przy przełączaniu z $I_F = 10$ mA na $U_R = 6$ V, dla $R_L = 100 \Omega$ $I_R = 1$ mA
Q_s	50	pC	przy przełączaniu z $I_F = 10$ mA na $U_R = 5$ V, dla $R_L = 500 \Omega$

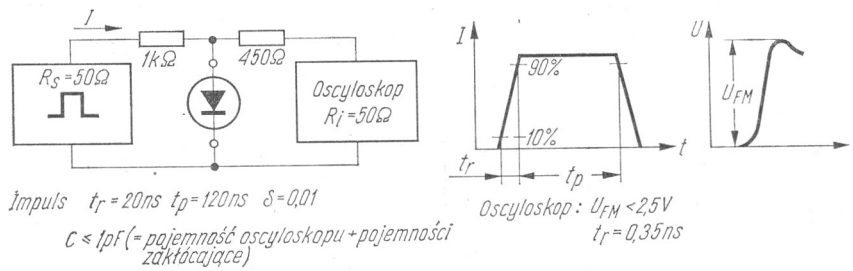
Wartości graniczne

U_R max	75	V	I_{FSM} max	2000 ²⁾	mA
U_{RRM} max	75	V	I_{FSM} max	500 ³⁾	mA
I_{FAV} max	100	mA	t_j max	200	$^\circ\text{C}$
I_F max	100	mA	$R_{th\ j-a}$ max	0,6	$^\circ\text{C}/\text{mW}$
I_{FRM} max	225	mA	t_{stg}	-65 ÷ +200	$^\circ\text{C}$

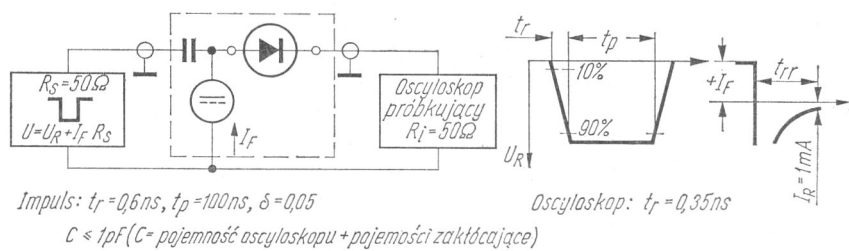
¹⁾ $t_j = 25^\circ\text{C}$

²⁾ $t = 1 \mu\text{s}$

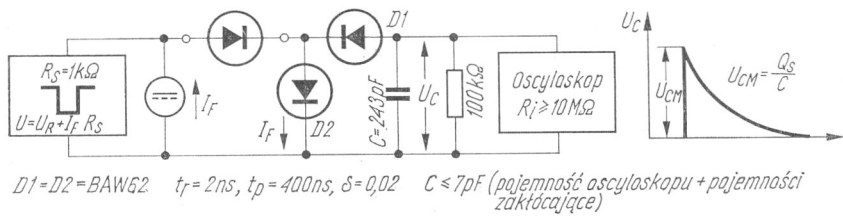
³⁾ $t = 1$ s



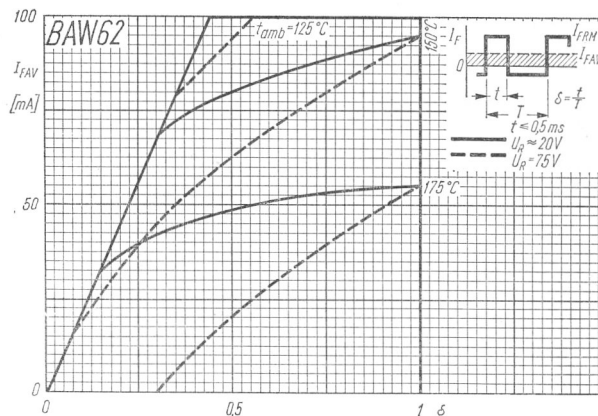
Rys. 2-67. Układ pomiarowy szczytowego napięcia diody w kierunku przewodzenia



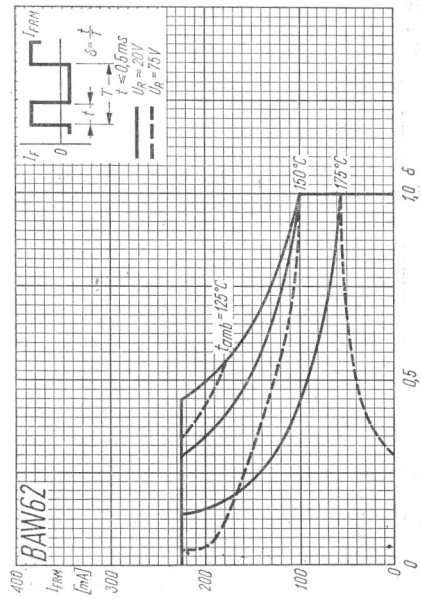
Rys. 2-68. Układ pomiarowy czasu ustalania prądu wstecznego diody



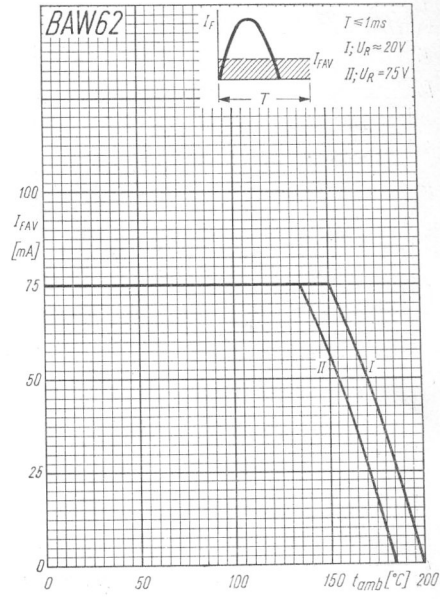
Rys. 2-69. Układ pomiarowy ładunku przełączania



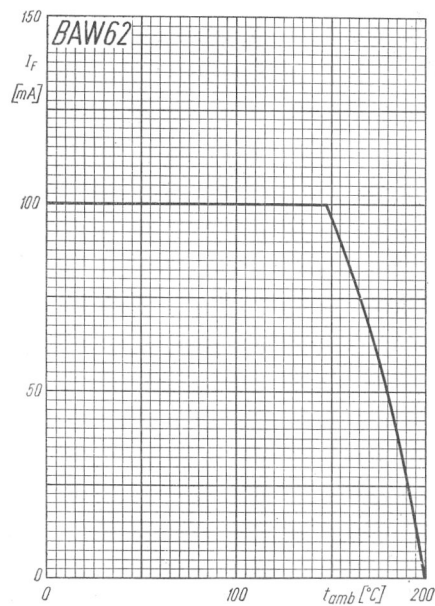
Rys. 2-70. Zależność średniego prądu przewodzenia diody od przebiegu czasowego impulsu



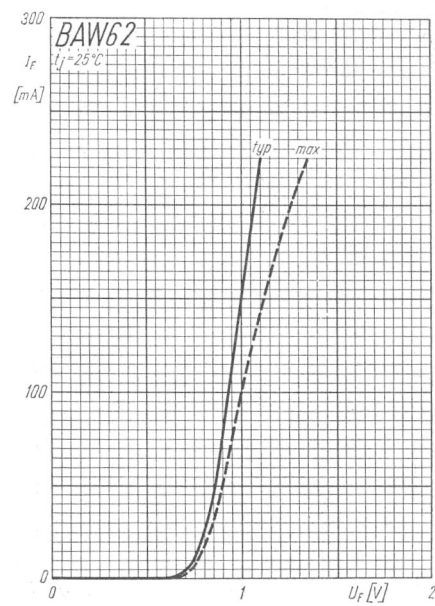
Rys. 2-71. Zależność szczytowego powtarzalnego prądu przewodzenia od przebiegu czasowego impulsu



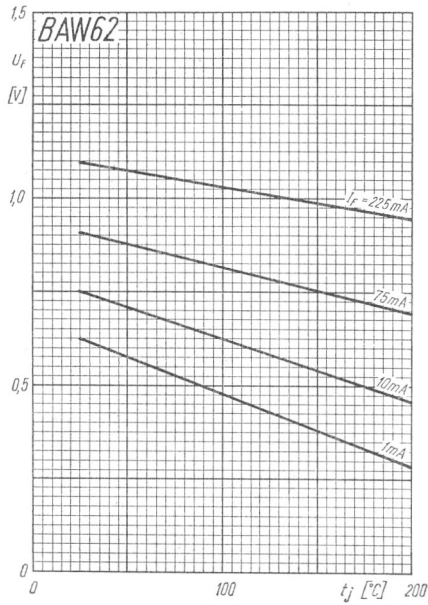
Rys. 2-72. Zależność średniego prądu przewodzenia diody od temperatury otoczenia



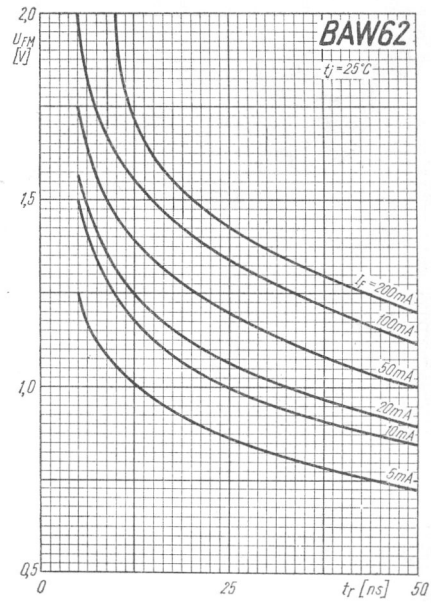
Rys. 2-73. Zależność prądu przewodzenia diody od temperatury otoczenia



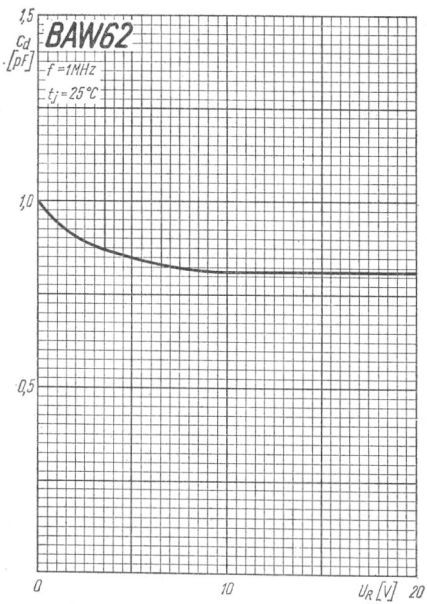
Rys. 2-74. Charakterystyka prądu przewodzenia diody



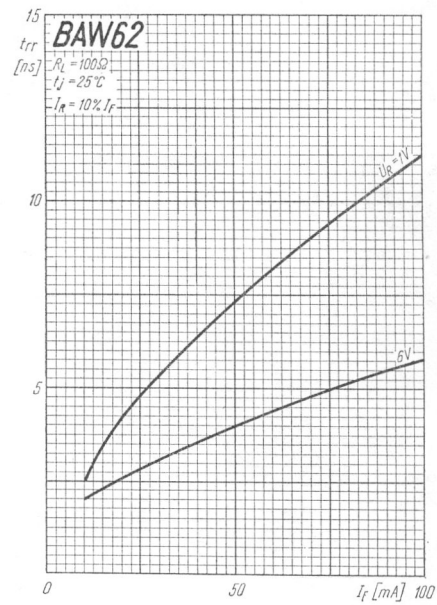
Rys. 2-75. Zależność napięcia diody w kierunku przewodzenia od temperatury złącza



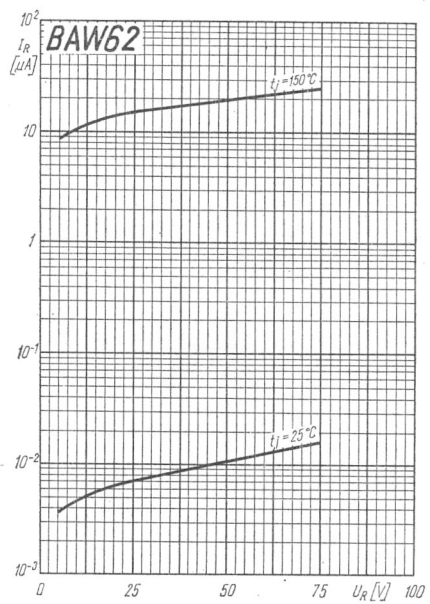
Rys. 2-76. Zależność szczytowego napięcia diody w kierunku przewodzenia od czasu narastania impulsu



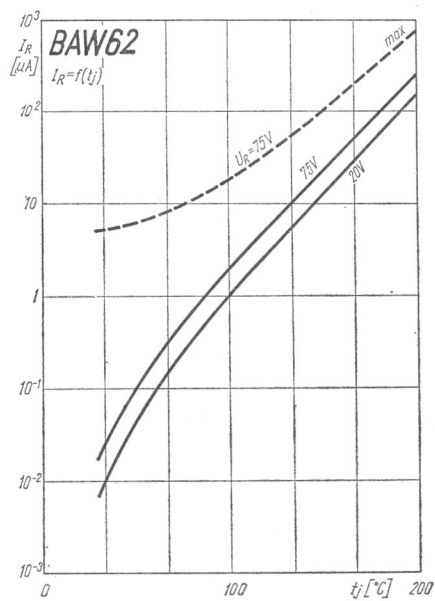
Rys. 2-77. Zależność pojemności diody od napięcia wstecznego



Rys. 2-78. Zależność czasu ustalania prądu wstecznego od prądu przewodzenia



Rys. 2-79. Charakterystyka prądu wstecznego diody



Rys. 2-80. Zależność prądu wstecznego diody od temperatury złącza